

KBU8A-KBU8M

Кремниевый диодный мост

Диапазон напряжения: 50 - 1000 В

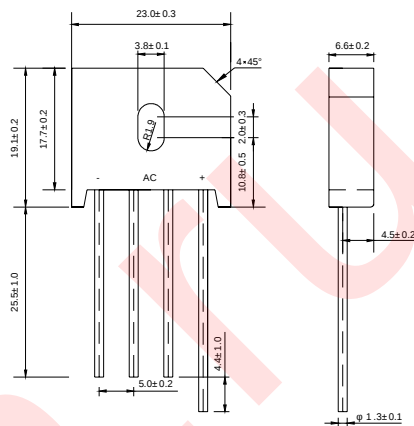
Ток: 8.0А

KBU



Особенности

- ◆ Номинальное напряжение до 1000В.
- ◆ Пиковая импульсная перегрузка до 250 А.
- ◆ Идеально подходит для печатной платы.
- ◆ Использование литого пластика снижает стоимость продукта.
- ◆ Пайка выводов MIL-STD-202 методика 208.



Размеры в миллиметрах.

Предельные значения и электрические характеристики

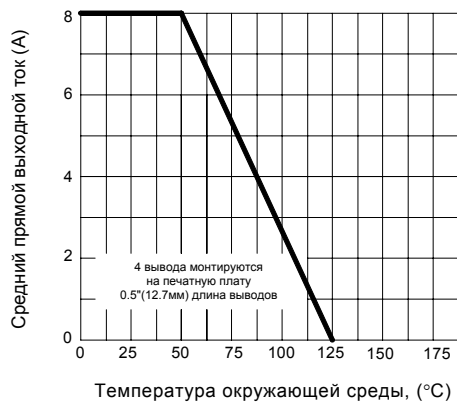
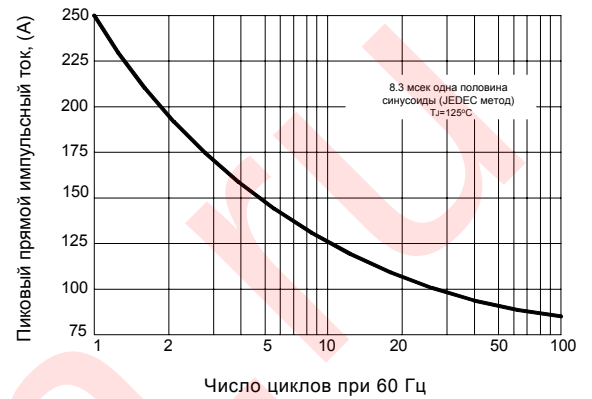
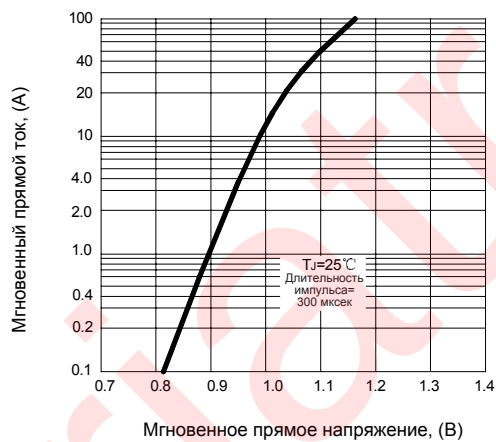
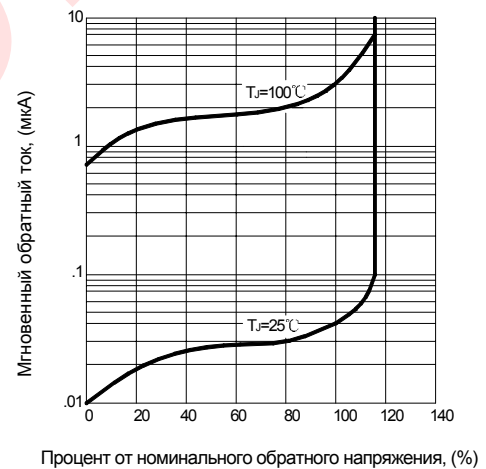
Значения параметров при 25°C температуре окружающей среды, если не указано иное.

Однофазный, напряжение (В) половина волны, частота – 60 Гц, для резистивных и индуктивных нагрузок.

Для емкостной нагрузки уменьшайте ток на 20%

Параметр	Обозначение	KBU 8A	KBU 8B	KBU 8D	KBU 8G	KBU 8J	KBU 8K	KBU 8M	Ед. измер
Макс. пиковое импульсное обратное напряжение	V_{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	В
Макс. среднеквадратическое значение напряжения	V_{RMS}	35	70	140	280	420	560	700	В
Макс. постоянное запирающее напряжение	V_{DC}	50	100	200	400	600	800	1000	В
Максимальный средний прямой ток $T_a = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$	$I_{F(AV)}$	8.0							А
Максимальный прямой ток импульса в течении 8.3 мсек. на номинальную нагрузку (JEDEC метод)	I_{FSM}	250.0							А
Макс. падение напряжения на открытом диоде @ 4.0 А	V_F	1.0							В
Максимальный постоянный обратный ток при номинальном постоянном обратном напряжении $T_a = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ $T_a = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$	I_R	10.0 1.0							мкА мА
Диапазон рабочих температур перехода	T_J	- 55 ---- + 125							$^{\circ}\text{C}$
Диапазон температур хранения	T_{STG}	- 55 ---- + 150							$^{\circ}\text{C}$

Графики характеристик

Рис.1 - График снижения выходного тока

Рис.2 - Максимальный неповторяющийся пиковый ударный прямой ток

Рис.3 - Типичная прямая характеристика

Рис.4 - Типичная обратная характеристика

Рис.5 - Типичная емкость перехода
